

## PNP SILICON AMPLIFIER TRANSISTOR

Qualified per MIL-PRF-19500/357

### Devices

<b>2N3634</b>	<b>2N3635</b>	<b>2N3636</b>	<b>2N3637</b>
<b>2N3634L</b>	<b>2N3635L</b>	<b>2N3636L</b>	<b>2N3637L</b>

### Qualified Level

**JAN**  
**JANTX**  
**JANTXV**  
**JANS**

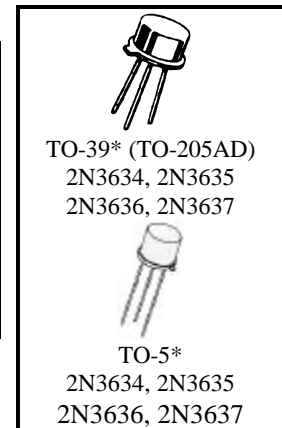
### MAXIMUM RATINGS

Ratings	Symbol	2N3634* 2N3635*	2N3636* 2N3637*	Unit
Collector-Emitter Voltage	$V_{CEO}$	140	175	Vdc
Collector-Base Voltage	$V_{CBO}$	140	175	Vdc
Emitter-Base Voltage	$V_{EBO}$	5.0		Vdc
Collector Current	$I_C$	1.0		Adc
Total Power Dissipation	$P_T$	@ $T_A = +25^{\circ}\text{C}^{(1)}$	1.0	W
		@ $T_C = +25^{\circ}\text{C}^{(2)}$	5.0	W
Operating & Storage Junction Temperature Range	$T_J, T_{stg}$	-65 to +200		$^{\circ}\text{C}$

\*Electrical characteristics for "L" suffix devices are identical to the "non L" corresponding devices

1) Derate linearly 5.71 mW/ $^{\circ}\text{C}$  for  $T_A > +25^{\circ}\text{C}$

2) Derate linearly 28.6 mW/ $^{\circ}\text{C}$  for  $T_C > +25^{\circ}\text{C}$



\*See appendix A for package outline

### ELECTRICAL CHARACTERISTICS ( $T_A = 25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise noted)

Characteristics	Symbol	Min.	Max.	Unit
-----------------	--------	------	------	------

#### OFF CHARACTERISTICS

Collector-Emitter Breakdown Current $I_C = 10 \text{ mAdc}$	2N3634, 2N3635 2N3636, 2N3637	$V_{(BR)CEO}$	140 175	Vdc
Collector-Base Cutoff Current $V_{CB} = 100 \text{ Vdc}$ $V_{CB} = 140 \text{ Vdc}$	2N3634, 2N3635	$I_{CBO}$	100 10	$\eta\text{Adc}$ $\mu\text{Adc}$
Emitter-Base Cutoff Current $V_{EB} = 3.0 \text{ Vdc}$ $V_{EB} = 5.0 \text{ Vdc}$		$I_{EBO}$	50 10	$\eta\text{Adc}$ $\mu\text{Adc}$
Collector-Emitter Cutoff Current $V_{CE} = 100 \text{ Vdc}$		$I_{CEO}$	10	$\mu\text{Adc}$

**2N3634, L, 2N3635, L, 2N3636, L, 2N3637, L JAN SERIES**

**ELECTRICAL CHARACTERISTICS (con't)**

Characteristics	Symbol	Min.	Max.	Unit	
<b>ON CHARACTERISTICS (3)</b>					
Forward-Current Transfer Ratio $I_C = 0.1 \text{ mAdc}, V_{CE} = 10 \text{ Vdc}$ $I_C = 1.0 \text{ mAdc}, V_{CE} = 10 \text{ Vdc}$ $I_C = 10 \text{ mAdc}, V_{CE} = 10 \text{ Vdc}$ $I_C = 50 \text{ mAdc}, V_{CE} = 10 \text{ Vdc}$ $I_C = 150 \text{ mAdc}, V_{CE} = 10 \text{ Vdc}$  $I_C = 0.1 \text{ mAdc}, V_{CE} = 10 \text{ Vdc}$ $I_C = 1.0 \text{ mAdc}, V_{CE} = 10 \text{ Vdc}$ $I_C = 10 \text{ mAdc}, V_{CE} = 10 \text{ Vdc}$ $I_C = 50 \text{ mAdc}, V_{CE} = 10 \text{ Vdc}$ $I_C = 150 \text{ mAdc}, V_{CE} = 10 \text{ Vdc}$	2N3634, 2N3636       2N3635, 2N3637	   $h_{FE}$       $h_{FE}$	25 45 50 50 30  55 90 100 100 60	150   300	
Collector-Emitter Saturation Voltage $I_C = 10 \text{ mAdc}, I_B = 1.0 \text{ mAdc}$ $I_C = 50 \text{ mAdc}, I_B = 5.0 \text{ mAdc}$	$V_{CE(sat)}$		0.3 0.6	Vdc	
Base-Emitter Saturation Voltage $I_C = 10 \text{ mAdc}, I_B = 1.0 \text{ mAdc}$ $I_C = 50 \text{ mAdc}, I_B = 5.0 \text{ mAdc}$	$V_{BE(sat)}$	0.65	0.8 0.9	Vdc	

**DYNAMIC CHARACTERISTICS**

Forward Current Transfer Ratio $I_C = 30 \text{ mAdc}, V_{CE} = 30 \text{ Vdc}, f = 100 \text{ MHz}$  $I_C = 10 \text{ mAdc}, V_{CE} = 10 \text{ Vdc}, f = 1.0 \text{ kHz}$	2N3634, 2N3636 2N3635, 2N3637  2N3634, 2N3636 2N3635, 2N3637	$ h_{fe} $  $h_{fe}$	1.5 2.0  40 80	8.0 8.5  160 320	
Small-Signal Short-Circuit Input Impedance $I_C = 10 \text{ mAdc}, V_{CE} = 10 \text{ Vdc}, f = 1.0 \text{ kHz}$	2N3634, 2N3636 2N3635, 2N3637	$h_{je}$	100 200	600 1200	$\Omega$ $\Omega$
Small-Signal Open-Circuit Output Admittance $I_C = 10 \text{ mAdc}, V_{CE} = 10 \text{ Vdc}, f = 1.0 \text{ kHz}$		$h_{oe}$		200	$\mu s$
Output Capacitance $V_{CB} = 20 \text{ Vdc}, I_E = 0, 100 \text{ kHz} \leq f \leq 1.0 \text{ MHz}$		$C_{obo}$		10	pF
Input Capacitance $V_{EB} = 1.0 \text{ Vdc}, I_C = 0, 100 \text{ kHz} \leq f \leq 1.0 \text{ MHz}$		$C_{ibo}$		75	pF
Noise Figure $V_{CE} = 10 \text{ Vdc}, I_C = 0.5 \text{ mAdc}, R_g = 1.0 \Omega$  $f = 100 \text{ Hz}$ $f = 1.0 \text{ kHz}$ $f = 10 \text{ kHz}$		NF		5.0 3.0 3.0	dB

**SAFE OPERATING AREA**

<b>DC Tests</b> $T_C = 25^{\circ}\text{C}, 1 \text{ Cycle}, t = 1.0 \text{ s}$	
<b>Test 1</b> $V_{CE} = 100 \text{ Vdc}, I_C = 30 \text{ mAdc}$ $V_{CE} = 130 \text{ Vdc}, I_C = 20 \text{ mAdc}$	2N3634, 2N3635 2N3636, 2N3637
<b>Test 2</b> $V_{CE} = 50 \text{ Vdc}, I_C = 95 \text{ mAdc}$	
<b>Test 3</b> $V_{CE} = 5.0 \text{ Vdc}, I_C = 1.0 \text{ Adc}$	

(3) Pulse Test: Pulse Width = 300 $\mu$ s, Duty Cycle  $\leq$  2.0%.



**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331